

Market News

StrongIRFET™ MOSFET in neuem Gehäuse für batteriegetriebene Anwendungen

München, 12. April 2017 – Die Infineon Technologies AG ergänzt die StrongIRFET™-Familie mit dem D²PAK 7pin+, einem 40-V-Baustein in neuem Gehäuse. Der neue MOSFET bietet einen extrem niedrigen $R_{DS(on)}$ von 0,65 mΩ und die branchenweit höchste Stromtragfähigkeit. Das erhöht die Robustheit und Zuverlässigkeit. Wichtig ist dies für Anwendungen mit großer Leistungsdichte, die einen hohen Wirkungsgrad und hohe Zuverlässigkeit erfordern. Das neue Gehäuse ist oberflächenmontierbar und die optimale Lösung für Niederspannungsantriebe, batteriebetriebene Werkzeuge und elektrische Leichtfahrzeugen.

D²PAK 7pin+ erweitert den hohen Variantenreichtum an Gehäusen für die StrongIRFET-Familie. Das erleichtert es, den optimalen Leistungshalbleiter für eine Vielzahl spezieller Design-Herausforderungen zu wählen. Die verschiedenen Optionen für die Pinbelegung ermöglichen zudem eine unübertroffene Designflexibilität. Im Vergleich zum D²PAK 7pin-Standardgehäuse liegt der $R_{DS(on)}$ der neuen Familie um bis zu 15 Prozent niedriger. Der thermische Widerstand von der Sperrschicht zur Leiterplatte ist um bis zu 39 Prozent geringer.

Das verbesserte Gehäuse bietet Platz für einen um 20 Prozent größeren Chip, bei identischer Pinbelegung und Grundfläche im Vergleich zum Standard-Gehäuse. Aus diesem Grund lassen sich damit die traditionellen D²PAK 7pin- und H²PAK-Gehäuse leicht ersetzen. Darüber hinaus liegt die Gate-Einsatzspannung auf Logic Level, der MOSFET kann somit direkt vom Mikrocontroller angesteuert werden. Das spart Platz auf der Leiterplatte und erhöht die Designflexibilität – gerade bei batteriegetriebenen Werkzeugen ist dies besonders wichtig.

Verfügbarkeit

Der StrongIRFET steht ab sofort im neuen Gehäuse D²PAK 7pin+ zur Verfügung. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/strongirfet.